

## 32KHz 出力 低周波数電圧変動 KH9829xxx

### 概要

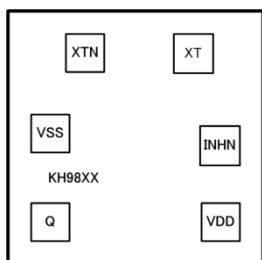
本 IC は、発振用アンプ、分周器及びスリーステートバッファより構成されます。発振段を内蔵定電圧源で駆動して IC の電源と分離する事によって周波数電圧変動の低減化を実現しました。

ESD、Latch-up 試験には信頼性の高い Automotive Electronics Council の半導体規格(AEC-Q100)を採用。

### 特長

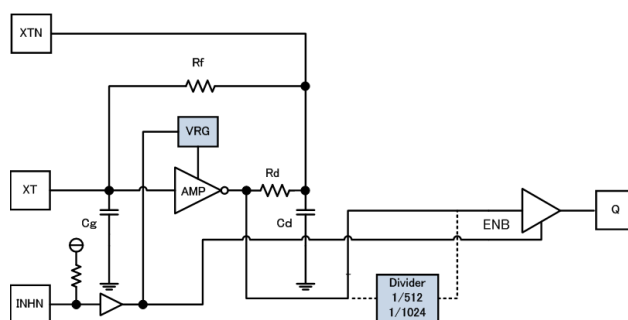
発振周波数 (基本波)	KH9829A10	16.777216MHz
	KH9829B11	33.554432MHz
出力周波数	16.777216MHz/512	32.768KHz
	33.554432MHz/1024	
動作電圧	1.6 ~ 3.63V	
動作温度	-40 ~ 85°C	
スタンバイモード INH <sub>N</sub> ="L"	Q 出力"Hi-z"	
	発振停止	
INH <sub>N</sub> 入力レベル	C-MOS	
Q 出力レベル	C-MOS	
Q 出力電流	2mA (VDD=1.6V)	
Q 出力負荷	15pF	

### PAD 配置図



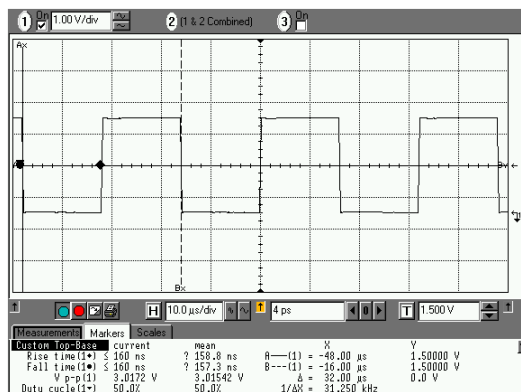
チップサイズ	0.74×0.67mm
パッドサイズ	90×90μm
チップ厚	130±20μm
チップ裏面	VSSレベル

### Block 図



### 出力波形

KH9829B11 32KHz CL=15pF VDD=3.0V



### 信頼性

試験モデル		耐性値
ESD	HBM	>4000V
	MM	>400V
	FI-CDM	>1000V
Latch-up	電流注入法	>200mA
	電源過電圧法	>5.4V

注) 本資料は簡易データシートです。正式版データシートをご希望の方は弊社へお問い合わせください。